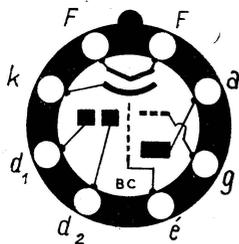
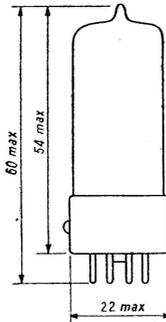


Duodiode-triode

Déetectrice, ampl. B.F.



CULOT VU DE DESSOUS
SUPPORT VU
COTE SOUDURES



CAPACITES

Elément triode

$C_g = 2,7$ pF
 $C_a = 1,7$ pF
 $C_{g a} = 1,5$ pF

Elément diode

$C_{d1} = 0,8$ pF
 $C_{d2} = 0,7$ pF
 $C_{d1 d2} < 0,3$ pF
 $C_{d1 f} < 0,1$ pF
 $C_{d2 f} < 0,05$ pF

Entre éléments

$C_{d1 g} < 0,007$ pF
 $C_{d2 g} < 0,03$ pF
 $C_{d1 a} < 0,01$ pF
 $C_{d2 a} < 0,01$ pF



LIMITES

Elément triode

Tension maximum sur l'anode, à froid	550	V
Tension maximum d'anode	250	V
Dissipation maximum d'anode	0,5	W
Courant maximum de cathode	5	mA
Tension max. de grille ($I_g = 0,3 \mu A$)	-1,3	V
Résistance maximum de grille	3	MΩ

(22 MΩ en cas de polarisation par fuite de grille)

Chaque diode

Tension maximum de crête	350	V
Courant maximum	0,8	mA
Tension max. de diode ($I_d = 0,3 \mu A$)	-1,3	V
Courant maximum de crête	5	mA
Tension max. filament-cathode	150	V
Résistance max. filament-cathode	20	kΩ

FILAMENT

Tension	14	V
Courant	0,1	A

UTILISATION

Tension anodique	100	170	V
Tension de grille	-1	-1,55	V
Courant d'anode	0,8	1,5	mA
Pente	1,4	1,65	mA/V
Coefficient d'amplification	70	70	
Résistance interne	50	42	kΩ

Amplificatrice B.F.

(1^{er} exemple)

Tension anodique	100		V
Résistance d'anode	100	220	kΩ
Résistance de cathode	3 900	5 600	Ω
Résistance de grille	1	1	MΩ
Résistance de grille de l'étage suivant (C liaison = 0,01 μF)	330	680	kΩ
Courant d'anode	0,28	0,18	mA
Gain	34	41	
Dist. pour sortie = 3 V eff	2	1,3	%
Dist. pour sortie = 5 V eff	3,5	1,9	%

(2^e exemple)

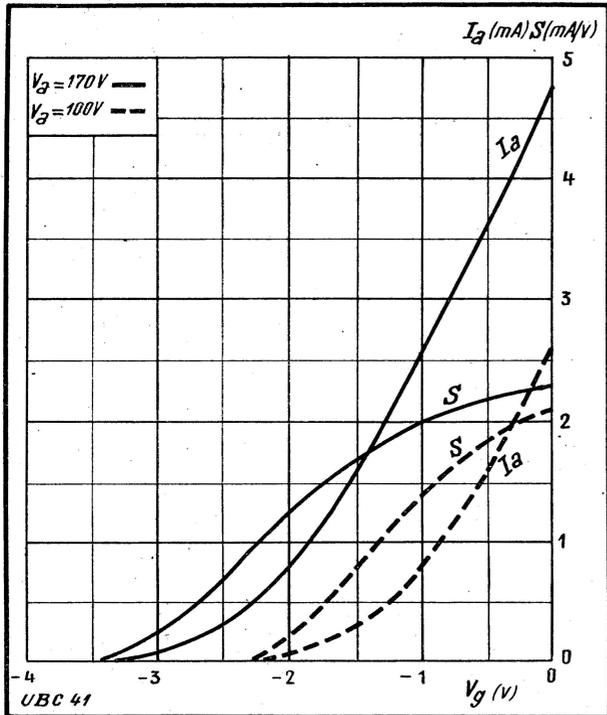
Tension anodique	170		V
Résistance d'anode	100	220	kΩ
Résistance de cathode	3 900	5 600	Ω
Résistance de grille	1	1	MΩ
Résistance de grille de l'étage suivant (C liaison = 0,01 μF)	330	680	kΩ
Courant d'anode	0,45	0,28	mA
Gain	37	44	
Dist. pour sortie = 3 V eff	1,1	1,1	%
Dist. pour sortie = 5 V eff	1,7	1,3	%
Dist. pour sortie = 8 V eff	2,6	1,85	%

(3^e exemple)

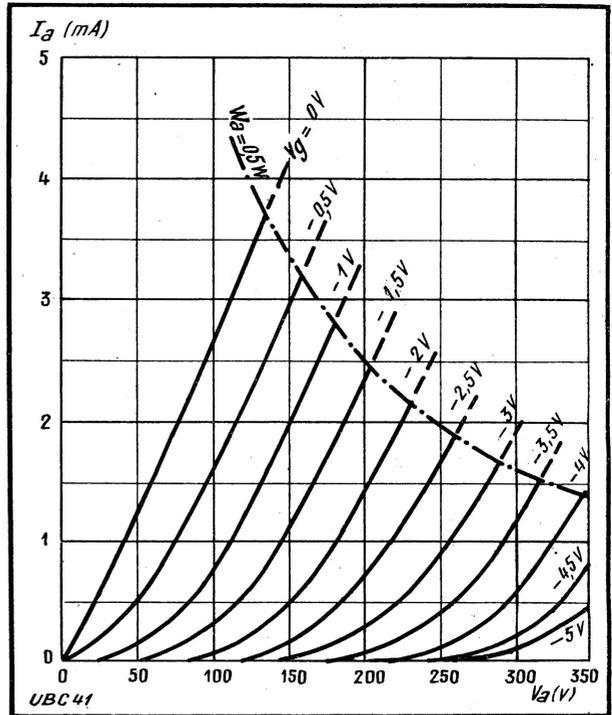
Tension anodique	100		V
Résistance d'anode	100	220	kΩ
Résistance de cathode	0	0	Ω
Résistance de grille	22	22	MΩ
Résistance de grille de l'étage suivant (C liaison = 0,01 μF)	330	680	kΩ
Courant d'anode	0,35	0,21	mA
Gain	35	41	
Dist. pour sortie = 3 V eff	1,6	1,45	%
Dist. pour sortie = 5 V eff	2,8	2	%

(4^e exemple)

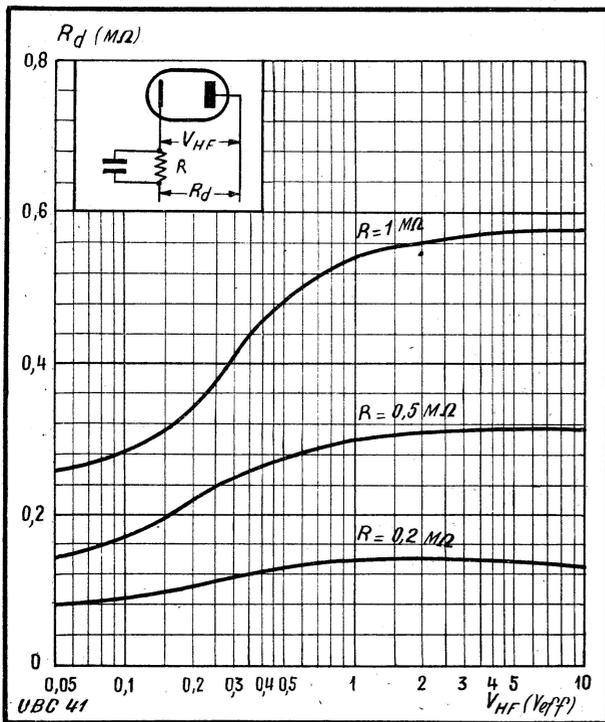
Tension anodique	170		V
Résistance d'anode	100	220	kΩ
Résistance de cathode	0	0	Ω
Résistance de grille	22	22	MΩ
Résistance de grille de l'étage suivant (C liaison = 0,01 μF)	330	680	kΩ
Courant d'anode	0,82	0,46	mA
Gain	42	48	
Dist. pour sortie = 3 V eff	0,75	0,95	%
Dist. pour sortie = 5 V eff	1	1,1	%
Dist. pour sortie = 8 V eff	1,2	1,3	%



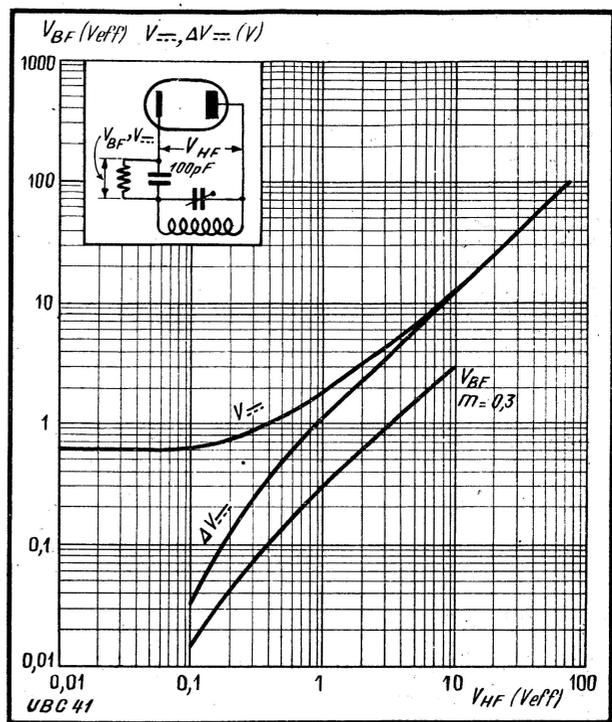
UBC 41 : Courant d'anode I_a et pente S en fonction de la tension de grille V_g .



UBC 41 : Courant d'anode I_a en fonction de la tension d'anode V_a pour différentes valeurs de la tension de grille V_g .



UBC 41 : Résistance d'amortissement H.F. R_d en fonction de la tension H.F. d'entrée V_{HF} pour trois valeurs de la résistance de détection.



UBC 41 : Composante alternative V_{BF} et composante continue V du signal détecté en fonction de la tension H.F. d'entrée V_{HF} (m = coefficient de modulation).